

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ

урочистих наукових зборів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, присвячених 100-річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР

МИХАЙЛА ФЕДОРОВИЧА ДЕЙГЕНА

Дата та місце проведення **19 червня 2018 року**
актовий зал Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, проспект Науки, 41, м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 10.00** Вступне слово директора ІФН НАН України, академіка НАН України **БЄЛЯЄВА О.Є.**
- 10.10** Виступ академіка-секретаря Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, академіка НАН України **ЛОКТЕВА В.М.**
- 10.20** **ШАНІНА Б.Д.**, доктор фізико-математичних наук, професор (ІФН НАН України) «Життєвий та творчий шлях М.Ф. Дейгена»
- 10.45** **КОЧЕЛАП В.О.**, член-кореспондент НАН України (ІФН НАН України). "М.Ф. Дейген і електрон-фононні взаємодії в напівпровідниках"
- 11.00** **ГЛІНЧУК М.Д.**, член-кореспондент НАН України (ІМЗ НАН України). "Залежні від розмірів фазові переходи без критичного розміру та зростання поляризації (reentrant phase) у наноструктурних сегнетоелектриках"
- 11.25** **РЯБЧЕНКО С.М.**, член-кореспондент НАН України (ІФ НАН України). "Прямі і непрямі екситони у подвійних квантових ямах CdMgTe/CdTe/CdMgTe/CdMnTe/CdMgTe". Автори: О.В. Терлецький, С.М. Рябченко (ІФ НАНУ), В.Й. Сугаков, Г.В.Верцимаха (ІЯД НАНУ), V.Yu.Ivanow, L.Owczarczyk, G. Karczewski (ІФ ПАН, Варшава).
- 11.50-12.10** **Перерва на каву**
- 12.10** **КАШИРІНА Н.І.**, кандидат фізико-математичних наук (ІФН НАН України). «Конденсони і біконденсони в низьковимірних системах»
- 12.35** **GERU I.I.**, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova. Institute of Chemistry. "Spin Levels Inversion in Exchange Coupled Pairs under Combined Time Reversal"
- 13.00** **БРАТУСЬ В.Я.**, доктор фізико-математичних наук (ІФН НАН України). "М.Ф. Дейген і експеримент у відділі радіоспектроскопії "
- 13.20** **ШАНІНА Б.Д.**, доктор фізико-математичних наук, професор (ІФН НАН України) «Обчислення з перших принципів констант спін гамільтоніана для протяжних дефектів»